

а 2021 0054

Изобретение относится к технологии производства наноструктурированных материалов, в частности, к способам получения наноструктур путем электрохимической обработки, которые могут применяться в микроэлектронике, оптоэлектронике и наноэлектронике.

Способ, согласно изобретению, заключается в изготовлении нанонитей GaAs или InP методом анодирования полупроводниковой подложки nGaAs или nInP в электролите, после чего подложку с изготовленными нанонитями подвергают термообработке при температуре 900°C, в течение 60 мин, в инертной атмосфере потока Ar с содержанием 3% кислорода, до получения на подложке GaAs или InP нанонитей Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> или In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, соответственно.

П. формулы: 1

Фиг.: 5